


② Теорема Гаусса для электрического поля в вакууме в интегральной и дифференциальной формах. Её применение для нахождения электростатических полей.

$d\vec{S} = \vec{n} dS$, где dS - площадь элементарной площади, а \vec{n} - единичный вектор нормали к этой площади


 потому вектора напряжённости поля \vec{E} и $d\vec{S}$ равен
 $d\Phi = E dS \cos \theta = \vec{E} d\vec{S}$
 потому через замкнутую поверхность равен
 $\Phi = \oint_S \vec{E} d\vec{S}$

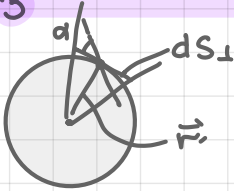
теорема Гаусса в интегральной форме

$\Phi = 4\pi q \quad \oint \vec{E} d\vec{S} = 4\pi q$

, где q - полный заряд, находясь в объёме V , ограниченной поверхностью S .

теорема Гаусса в дифференциальной форме

, где g - объёмная плотность заряда; $\text{div} \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \stackrel{||}{=} \nabla \cdot \vec{E}$

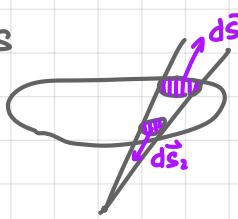


$d\Omega = \frac{dS_{\perp}}{r^2}$

$dS_{\perp} = dS \cos \alpha$
 $dS_{\perp} = d\vec{S} \cdot \frac{\vec{r}}{r}$

$d\Phi = \vec{E} d\vec{S} = \frac{q}{r^3} \vec{r} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{r^2} \frac{d\vec{S} \cdot \vec{r}}{r} = q \frac{dS_{\perp}}{r^2} = q d\Omega$
 от точечного заряда

$\Phi = \int d\Phi = q \int d\Omega = \begin{cases} 4\pi q, & q \text{ внутри } S \\ 0, & q \text{ снаружи} \end{cases}$



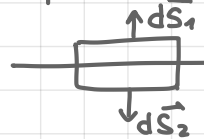
$$\left[\oint_S \vec{a} d\vec{S} = \int_V \text{div} \vec{a} dV \right] \quad \nabla \cdot \vec{E}$$

$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \int_V \text{div} \vec{E} dV$$

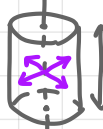
$$\Rightarrow \int_V 4\pi g dV \quad \nabla \cdot \vec{E} = 4\pi g$$

Примеры применения


1. равномерно заряженная плоскость


 $\Phi = \vec{E}_1 d\vec{S}_1 + \vec{E}_2 d\vec{S}_2 = 2E dS$
 $\stackrel{||}{=} \text{th. Гаусса} \Rightarrow E = 2\pi \sigma$
 $4\pi \sigma \cdot dS$
 q

2. поле равномерно заряженной нити


 $\Phi = 2\pi r \cdot dl \cdot E(r) = 4\pi g \cdot dl \Rightarrow E(r) = \frac{2g}{r}$

3. равномерно заряженный шар


 $\Phi = E(r) 4\pi r^2 = 4\pi q(r)$
 $r < R: q(r) = \frac{4}{3}\pi r^3 g = Q \left(\frac{r}{R}\right)^3 \Rightarrow \vec{E} = \frac{4\pi}{3} g \vec{r}$
 $r \geq R: q(r) = Q \Rightarrow \vec{E} = \frac{Q}{r^3} \vec{r}$, где Q - полный заряд шара

4. поле в сферической полости внутри шара

еще и полости не было:


$\vec{E}_1 = \frac{4\pi}{3} g \vec{r}_1$

отсутствие зарядов в полости \Leftrightarrow шар с g + "полость" с $-g$

$\vec{E}_2 = \frac{4\pi}{3} (-g) \vec{r}_2$

тогда $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{4\pi}{3} g (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = \frac{4\pi}{3} g \vec{b}$, где \vec{b} - вектор, соединяющий центр шара и полости.

В исходно нейтральном шаре помн. заряды, сместим отп. отрицательных на $\delta \vec{e}$


 $\vec{E}_+ = \frac{4\pi}{3} g \vec{r}_+$
 $\vec{E}_- = -\frac{4\pi}{3} g \vec{r}_-$
 $\Rightarrow \vec{E} = \frac{4\pi}{3} g (\vec{r}_+ - \vec{r}_-) = -\frac{4\pi}{3} g \delta \vec{e}$

еще шара поле такой системы поверхностных зарядов совпадает с полем точечного диполя, поскольку поле от каждого из шаров совп. с полем точечных зарядов, расположенных в цент.

ре шаров. величина $\vec{S\ell}$ — нгено ташото ашало.

найдём распределение заряда по поверхности шара.



$$R^2 = (R-x)^2 + 2(R-x)S\ell \cos \vartheta + (S\ell)^2$$

$$x = S\ell \cos \vartheta$$

↓

$$\sigma' = \sigma_0 \cos \vartheta = g S\ell \cos \vartheta$$